

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі випускової кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки зі спеціальності 171 “Електроніка”

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади, місце роботи	Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи								
1	Голота Віктор Іванович	Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Київський орденна Леніна політехнічний інститут, 1984, спеціальність – електронні обчислювальні машини, кваліфікація – інженер системотехнік.	Кандидат технічних наук, 05.27.01 - твердотільна електроніка, «Автоемісійні мікро-катоди з елементами керування на структурах «кремній-на ізоляторі», Доцент кафедри радіофізики і електроніки.	11 років	1. Druzhinin, A., Khoverko, Y., Kogut, I., Holota, V. Deformation characteristics of SOI structures at cryogenic temperatures // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017 – Proceedings 7939723, pp. 92-95. 2. В.В. Довгий, І.Т. Когут, В.І. Голота. Розробка і моделювання елементів аналітичної мікросистеми-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі” // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №2. – С. 275-280. 3. V. Dovhij, V. Holota, I. Kogut.	Національний університет “Львівська політехніка”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 80709 6, тема “Схемотехнічне проектування асинхронних цифрових автоматів”, 2 червня	п. 1 (наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus); п. 2 (наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України); п. 12 (наявність авторських свідоцтв); п. 13 (наявність виданих навчально-методичних

						<p>Architecture development and elements simulation of analytical microsystem-on-chip with "silicon-on-insulator" structures // Proceedings of the 13th International Conference "TCSET'2016" – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 368-372.</p> <p>4. A.A. Druzhinin, I.T. Kogut, A.Yu. Khoverko, V.I. Golota, Yu.M. Khoverko. Semiconductor integrated elements based on nanostructures silicon for information systems // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2015. – T. 12, №1. – P. 100-107.</p> <p>5. V. Holota, I. Kogut, A. Druzhinin, Yu. Khoverko. High sensitive active MOS photo detector on the local 3D SOI-structure // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 854. – P. 45-47.</p>	2014 р.	посібників); згідно п. 30 ЛУ
2	Когут Ігор Тимофійович	Зав. кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Львівський ордина Леніна політехнічний інститут, 1975 р, спеціальність - «напівпровідникові прилади», кваліфікація - «інженер електронної техніки»	Доктор технічних наук, 05.27.01 - твердотільна електроніка. «Елементи мікросистем на базовому матричному кристалі зі структурою «кремній-на-ізоляторі», Професор кафедри радіофізики і електроніки	33 роки	<p>1. Druzhinin, A., Khoverko, Y., Kogut, I., Holota, V. Deformation characteristics of SOI structures at cryogenic temperatures // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017 – Proceedings 7939723, pp. 92-95</p> <p>2. I.T. Kogut, V.I. Holota, A.A. Druzhinin, V.V. Dovhiy. The device technological simulation of local 3D SOI structures // Journal of Nanoresearch. – 2016. – V. 39. – P. 228-234.</p> <p>3. A.A. Druzhinin, I.T. Kogut, A.Yu. Khoverko, V.I. Golota, Yu.M. Khoverko. Semiconductor integrated elements based on nanostructures silicon for information systems // Sensor Electronics and</p>	<p>Національний університет "Львівська політехніка", Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 807094, тема "Моделювання елементів спеціалізованих сенсорних мікросистем-на-кристалі зі структурою "кремній-на-ізоляторі", 2 червня</p>	<p>п. 1 (наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus);</p> <p>п. 2 (наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України);</p> <p>п. 3 (наявність монографії, особистий внесок 20 %);</p> <p>п. 4 (наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня);</p> <p>п. 10 (завідувач кафедри);</p> <p>п. 11 (участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент);</p> <p>п. 12 (наявність авторських</p>

						<p>Microsystem Technologies. – 2015. – Т. 12, №1. – P. 100-107.</p> <p>4. V. Holota, I. Kogut, A. Druzhinin, Yu. Khoverko. High sensitive active MOS photo detector on the local 3D SOI-structure // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 854. – P. 45-47.</p> <p>5. A. Druzhinin, Yu. Khoverko, I. Kogut, R. Koretskii. Properties of low-dimentional polysilicon in SOI structures for low temperature sensors // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 854. – P. 49-55.</p>	2014 р.	свідоцтв); п. 13 (наявність виданих навчально-методичних посібників) згідно п. 30 ЛУ
3	Новосядлий Степан Петрович	Професор кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Львівський політехнічний інститут, 1964 р., спеціальність - напівпровідникові прилади. кваліфікація інженер - електрик	Доктор технічних наук, 05.27.01 - твердотільна електроніка. «Фізико-технологічні основи формування субмікронних структур ВІС», Професор кафедри радіофізики і електроніки	24 років	<p>1. Novosyadlyj, S., Dzundza, B., Gryga, V., Kotyck, M., Mandzyuk, V. Research Into Constructive And Technological Features Of Epitaxial Galliumarsenide Structures Formation On Silicon Substrates // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V 3, N 5 (87). – P. 54-61.</p> <p>2. С.П. Новосядлий, С.І. Бойко, М.В. Котик. Особливості формування багаторівневої металізації в субмікронних структурах великих інтегральних схем // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №4. – С. 618-624.</p> <p>3. Новосядлий С.П., Мельник Л.В. Сучасні проблеми САПР технології структур ВІС: монографія. – Івано-Франківськ: ПП Майданчук І.І. 2015, 228 с.</p> <p>4. Новосядлий С.П. Високоєфективні структури ФЕП: монографія. – Івано-Франківськ: Сімік, 2015. 350 с.</p> <p>5. С.П. Новосядлий, С.І. Бойко, Л.В. Мельник, С.В. Новосядлий.</p>	<p>Національний університет "Львівська політехніка", Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 8547 81, тема "Сучасні проблеми САПР топологій субмікронних структур ВІС спеціалізованих комп'ютерних систем", 2 червня 2015 р.</p>	<p>п. 1 (наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus);</p> <p>п. 2 (наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України);</p> <p>п. 3 (наявність навчального посібника, що рекомендований МОН);</p> <p>п. 7 (член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України);</p> <p>п. 10 (заступник завідувача кафедри, керівник лабораторії);</p> <p>п. 11 (участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент);</p> <p>п. 12 (наявність патентів);</p> <p>п. 14 (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання);</p>

						Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 6, №5(78). – С. 32-40.		п. 15 (наявність науково-популярних дискусійних публікацій) згідно п. 30 ЛУ
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Проректор з науково-педагогічної роботи



Р.І. Запухляк

Кадровий склад

Якісний склад випускової кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки зі спеціальності 171 “Електроніка”

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові викладача	Посади (для сумісників - місце основної роботи, посада)	Назва закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з дипломом)	Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Назви всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, (кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни)	Наукова діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів, їх рівень та ефективність)	Підвищення кваліфікації викладача (назва організації, де відбулося підвищення кваліфікації, вид документа, тема, дата видачі)
Особи, які працюють за основним місцем роботи							
1	Когут Ігор Тимофійович	Завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Львівський політехнічний інститут, 1975 р, спеціальність - «напівпровідникові прилади», кваліфікація - «інженер електронної техніки»	Доктор технічних наук зі спеціальності - 05.27.01 - твердотільна електроніка, диплом ДД 008494, Тема дисертації: «Елементи мікросистем на базовому матричному кристалі зі структурою «кремній-на-ізоляторі», 2010 р. професор кафедри радіофізики і електроніки, атестат 12ПР № 007566	<i>ОКР магістр</i> Дослідження і проектування елементів ІС та сенсорів - 16 год; Компютерна схемотехніка – 24 год Моделювання і проектування цифрових пристроїв БМК - 30 год.	1. Druzhinin, A., Khoverko, Y., Kogut, I., Holota, V. Deformation characteristics of SOI structures at cryogenic temperatures // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017 – Proceedings 7939723, pp. 92-95 2. I.T. Kogut, V.I. Holota, A.A. Druzhinin, V.V. Dovhiy. The device technological simulation of local 3D SOI structures // Journal of Nanoresearch. – 2016. – V. 39. – P. 228-234. 3. A.A. Druzhinin, I.T. Kogut, A.Y. Khoverko, V.I. Golota, Yu.M. Khoverko. Semiconductor integrated elements based on nanostructures silicon for information systems // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2015. – T. 12, №1. – P. 100-107. 4. V. Holota, I. Kogut, A. Druzhinin, Yu. Khoverko. High sensitive active MOS photo detector on the local 3D SOI-structure // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 854. – P. 45-47. 5. Druzhinin, Yu. Khoverko, I. Kogut, R. Koretskii. Properties of low-dimentional polysilicon in SOI structures for low temperature sensors // Advanced Materials	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп'ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп'ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 807094, тема “Моделювання елементів спеціалізованих сенсорних мікросистем-на-кристалі зі структурою “кремній-на-ізоляторі”, 2 червня 2014 р.

						Research. – 2014. – V. 854. – P. 49-55.	
2	Новосядлий Степан Петрович	Професор кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Львівський політехнічний інститут, 1964 р, спеціальність «напівпровідникові прилади», кваліфікація «інженер-електрик»	Доктор технічних наук зі спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка, диплом ДД № 003704, Тема дисертації: «Фізико-технологічні основи формування субмікронних структур ВІС», 2003 р. професор кафедри радіофізики і електроніки атестат ПР № 003007	ОКР- бакалавр Аналогова і цифр. обробка сигналів – 20 год; Теорія електричних і магнітних кіл - 40 год; Твердотільна електроніка – 18 год; Аналогова і цифрова схемотехніка - 24 год; Техніка і електроніка НВЧ - 14 год; ОКР - магістр Основи радіоелектроніки - 14 год.	1. Novosyadlyj, S., Dzundza, B., Gryga, V., Kotyk, M., Mandzyuk, V. Research Into Constructive And Technological Features Of Epitaxial Galliumarsenide Structures Formation On Silicon Substrates // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V 3, N 5 (87). – P. 54-61. 2. С.П. Новосядлий, С.І. Бойко, М.В. Котик. Особливості формування багаторівневої металізації в субмікронних структурах великих інтегральних схем // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №4. – С. 618-624. 3. Новосядлий С.П., Мельник Л.В. Сучасні проблеми САПР технології структур ВІС: монографія. – Івано-Франківськ: ПП Майданчук І.І. 2015, 228 с. 4. Новосядлий С.П. Високоєфективні структури ФЕП: монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 350 с. 5. С.П. Новосядлий, С.І. Бойко, Л.В. Мельник, С.В. Новосядлий. Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 6, №5(78). – С. 32-40.	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп'ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп'ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 854781, тема “Сучасні проблеми САПР топологій субмікронних структур ВІС спеціалізованих комп'ютерних систем”, 2 червня 2015 р.
3	Павлюк Мирослав Федорович	Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаніка, 1985 р., спеціальність «математика», кваліфікація «вчитель	Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності - 01.04.18 фізика і хімія поверхні, диплом КН № 004743, Тема дисертації: «Структура і електрофізичні	ОКР- бакалавр Інженерна та комп'ютерна графіка - 48 год; Напівпровідникова електроніка - 16 год; Мікроконтролерна техніка - 24 год; Архітектура ЕОМ -	1. В.П. Махній, М.Ф. Павлюк, М.Д. Раранський, С.В. Хуснутдінов. Особливості структурних властивостей гетерошарів оксиду цинку // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2015. – Т. 3, Випуск 2. – С. 54-57. 2. R.O. Dzumedzey, V.V. Boryk, M.F. Pavliuk, O.Yu. Kalka, R.I. Zapukhliak. Calculation of Thermoelectric Parameters	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп'ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп'ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОД 02071010/573-16,

			математики»	властивості плівок телурид свинцю – селенід олова», 1994 р. доцент кафедри фізики твердого тіла, атестат ДЦ АЕ № 001840	10 год Комп'ютерні меражі – 30 год	PbTe // Materials XV International conference on physics and technology of thin films and nanosystems: Ivano-Frankivsk, May,11-16, 2015. – P. 317. 3. В.П. Махній, Г.І. Бодюл, М.Ф. Павлюк, І.І. Герман. Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2014. – Т 3, Випуск 1. – С. 74-76. 4. В.П. Махній, І.В. Ткаченко, М.Ф. Павлюк, О.І. Черних. Моделювання процесів дефектоутворення в кристалах ZnSe з ізовалентною домішкою Mg // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №3. – С. 548-551. 5. О.Л. Соколов, Я.П. Салій, І.С. Билина, М.Ф. Павлюк Процеси формування конденсаторів CdTe // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, №2. – С. 420-426.	тема “Спеціалізована комп’ютерна система автоматичного вимірювання електричних параметрів на основі мікроконтролера Atmega 16”, 30 листопада 2016 р.
4	Голота Віктор Іванович	Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки	Київський політехнічний інститут, 1984 р, спеціальність «електронні обчислювальні машини», кваліфікація «інженер-системотехнік»	Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка, диплом ДК № 055537, Тема дисертації: «Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах «кремній - на ізоляторі», 2009 р. доцент кафедри радіофізики і електроніки, атестат 12ДЦ № 029867	<i>ОКР- бакалавр</i> Системне програмне забезпечення - 14 год; Системне програмування - 14 год; <i>ОКР магістр</i> Архітектура і програмування ПЛІС на мові Verilog- 28 год; <i>ОКР - магістр</i> Прикладні програми комп’ютерної інженерії - 14 год.	1. Druzhinin, A., Khoverko, Y., Kogut, I., Holota, V. Deformation characteristics of SOI structures at cryogenic temperatures // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017 – Proceedings 7939723, pp. 92-95 2. В.В. Довгий, І.Т. Когут, В.І. Голота. Розробка і моделювання елементів аналітичної мікросистеми-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі” // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №2. – С. 275-280. 3. V. Dovhij, V. Holota, I. Kogut. Architecture development and elements simulation of analytical microsystem-on-chip with "silicon-on-insulator" structures // Proceedings of the 13th International Conference “TCSET’2016” – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National University, 2016.	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп’ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп’ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 807096, тема “Схемотехнічне проектування асинхронних цифрових автоматів”, 2 червня 2014 р.

						<p>– P. 368-372.</p> <p>4. A.A. Druzhinin, I.T. Kogut, A.Y. Khoverko, V.I. Golota, Yu.M. Khoverko. Semiconductor integrated elements based on nanostructures silicon for information systems // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2015. – Т. 12, №1. – P. 100-107.</p> <p>5. V. Holota, I. Kogut, A. Druzhinin, Yu. Khoverko. High sensitive active MOS photo detector on the local 3D SOI-structure // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 854. – P. 45-47.</p>	
5	Терлецький Андрій Іванович	Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника, 1989 р., спеціальність «фізика і математика», кваліфікація «вчитель фізики і математики»	Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків, диплом D № 000266; Тема дисертації: «Вплив радіаційного впливу на випромінювання і електричні характеристики фосфіду індію і арсеніду галію», 1994 р. доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки, атестат 12ДЦ № 033546	ОКР- бакалавр Архітектура комп'ютерів – 44 год; Комп'ютерна логіка - 36 год; Алгоритми і методи обчислень - 22 год; Основи метрології - 14 год; Метрологія, стандартизація і сертифікація - 36 год; Периферійні пристрої - 24 год; Вступ до систем автоматизованого керування - 24 год	<p>1. Новосядлий С.П., Терлецький А.І. Діагностика субмікронних структур ВІС: монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, – 2016. – 480 с.</p> <p>2. С.П. Новосядлий, А.І. Терлецький, О.Б. Фрик. Генераційні параметри межі розділу кремній-оксид РЗМ в МДН-системах. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах”, 3-5 листопада 2016, Чернівці, Україна. – С. 248.</p> <p>3. S.P. Novosyadly, A.I. Terletsky, O.B. Fryk. Electrical and mechanical properties of ionplasma deposited carbon films // International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2016). – 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine. – P. 249.</p> <p>4. С.П. Новосядлий, А.І. Терлецький, О.Б. Фрик. Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №2. – С. 420-424.</p> <p>5. I.T. Kogut, V.I. Holota, V.V. Dovhuj, A.I. Terletsky, O.B. Fryk. The computer</p>	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп'ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп'ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОД 02071010/571-16, тема “Охоронна система автомобіля на базі мікроконтролера PIC”, 30 листопада 2016 р.

						simulation of 3D SOI-structures for sensitive elements // Матеріали XIV Міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – 20-25 травня, Івано-Франківськ, Україна. – 2013. – Р. 459-463.	
6	Мандзюк Володимир Ігорович	Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки	Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 2000 р., спеціальність «фізика», кваліфікація «фізик, викладач»	Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.24 - фізика колоїдних систем, диплом ДК № 031856, Тема дисертації: «Інтеркаляція іонів літію в кремнезем і цеоліти», 2005 р. доцент кафедри радіофізики і електроніки, атестат 12ДЦ № 026848	ОКР – бакалавр Мікро- і нано-елементна база - 14 год; Радіотехнічні кола і сигнали - 30 год; Схемотехніка - 14 год; Статистична радіофізика - 14 год; Комп’ютерна електроніка - 22 год; Основи інтегральної електроніки - 34 год.	1. Novosiadlyi, S., Kotyk, M., Mandzyuk, V. Formation of carbon films as the substrate dielectric of GaAs microcircuits on Si-substrates // Eastern European Journal of Enterprise Technologies 5(5-89), pp. 26-34. 2. I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V.11 (508). – P. 1-9. 3. I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural and morphological features of dispersed alumina synthesized using aluminum nitrate nonahydrate // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V.11 (153). – P. 1-8. 4. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.М. Сачко, Ю.О. Кулик. Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO ₂ – C // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №4. – С. 700-705. 5. В.К. Ostafiychuk, V.I. Mandzyuk, Yu.O. Kulyk, N.I. Nagirna. SAXS investigation of nanoporous structure of thermal-modified carbon material // Nanoscale Research Letters. – 2014. – V. 9. – P. 1-6.	Національний університет “Львівська політехніка”, напрям підготовки “Комп’ютерна інженерія” спеціальності “Спеціалізовані комп’ютерні системи”, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОД 02071010/572-16, тема “Спеціалізована комп’ютерна система автоматичного регулювання освітленості на базі мікроконтролера Atmega 16L”, 30 листопада 2016 р.
7	Грига Володимир Михайлович	Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки	Національний університет "Львівська політехніка", 2004 р., спеціальність	Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.05 - комп’ютерні системи та компоненти диплом ДК № 031959	ОКР – бакалавр Паралельні та розподілені обчислення - 22 год; Технології	1. Novosyadlyj, S., Dzundza, B., Gryga, V., Kotyk, M., Mandzyuk, V. Research Into Constructive And Technological Features Of Epitaxial Galliumarsenide Structures Formation On Silicon Substrates // Eastern European Journal of Enterprise	Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захищена в 2015 р.

			<p>"спеціалізовані комп'ютерні системи", кваліфікація "магістр з комп'ютерних систем"</p>	<p>Тема дисертації: «Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання математичних операцій», 2015 р.</p>	<p>проектування комп'ютерних систем - 30 год; Мікроконтролерна техніка - 14 год; <i>ОКР – магістр</i> Програмне забезпечення СКС - 14 год; Проектування спеціалізованих систем на кристалі - 30 год.</p>	<p>Technologies. – 2017. – V 3, N 5 (87). – P. 54-61. 2. В. Krulikovskiy, A. Davletova, V. Gryga, Y. Nykolaichuk. Synthesis of components of high performance special processors of execution of arithmetic and logical operations data processing in theoretical and numerical basis rademacher // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of XIVth International Conference. CADSM'2017. – Lviv-Poljana, Ukraine, 2017. – P. 114- 118. 3. V. Gryga, I. Kolosov, O.Danyluk. The development of a fast iterative algorithm structure of cosine transform // Modern Problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of XIIIth International Conference. TCSET'2016. – Lviv-Poljana, Ukraine, 2016. – P. 506-509. 4. R. Dunets, V. Gryga. Spatio-temporal synthesis of transformation matrix of reverse fast cosine transformation // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of XIIIth International Conference. CADSM'2015. – Lviv-Poljana, Ukraine, 2015. – P. 45-49. 5. В. Грига. Дослідження комутуючої мережі Бенеша на основі просторово-часових графів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання” – Івано-Франківськ-Яремче, Україна, 2016. – С. 97-98. 6. Р.Б. Дунець, В.М. Грига. Исследование матричных методов представления поточных графов алгоритмов / Р. Б. Дунець, В. М. Грига // Вестник “Физика, математика, информатика” – Брест (Беларусь): Брестский государственный</p>
--	--	--	---	---	--	--

						технический университет, 2013. – №5(83) – С. 41–46.	
8	Дзундза Богдан Степанович	Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки	Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника 2004 р спеціальність "Фізика", кваліфікація Фізик. Викладач	Кандидата фізико-математичних наук (ДК051963, протокол № 12-07/1 28.04.2009). Старший науковий співробітник (АС000909 4.07.2013). 01.04.18 – фізика і хімія поверхні Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю.	ОКР магістр Автоматизація проектування друкованих плат - 30 год; ОКР магістр Інтернет технології та Web-дизайн - 24 год; Елементна база оптичних обчислювальних пристроїв - 10 год; Вступ до систем автоматизованого керування - 32 год; Інженерія програмного забезпечення - 32 год; Статистична радіофізика - 14 год;	1. Novosyadlyj, S.,Dzundza, B.,Gryga, V.,Kotyк, M.,Mandzyuk, V. Development of technology of superconducting multilevel wiring in speed gaas structures of LSI/VLSI // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V 1, N 5 (91). – P. 53-62. 2. Novosyadlyj, S.,Dzundza, B.,Gryga, V.,Kotyк, M.,Mandzyuk, V. Research Into Constructive And Technological Features Of Epitaxial Galliumarsenide Structures Formation On Silicon Substrates // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V 3, N 5 (87). – P. 54-61. 3. Saliy, Y.P., Dzundza, B.S., Bylina, I.S., Kostyuk, O.B. The influence of the technological factors of obtaining on the surface morphology and electrical properties of the PbTe films doped Bi // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – V. 8, N2. – P. 02045-1 – 02045-6. 4. Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк, В.І. Маковишин, Р.С. Яворський Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 на слюді // Фізика і хімія твердого тіла – 2015. – Т. 16, №1. – С. 93-97. 5. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Маковишин В.І., Межиловська Л.Й. Бачук В.В. Термоелектричні властивості парофазних конденсатів на основі легованого телуриду олова SnTe:Bi // Термоелектрика – 2014. –№3. – С. 24-27.	Курси підвищення кваліфікації викладачів ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України», м. Київ, свідоцтво № 112-14-13, 21.03.2014 р

Проректор з науково-педагогічної роботи

Р.І. Запухляк

**Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії)
зі спеціальності 171 “Електроніка”**

Прізвище, ім'я, по батькові	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, категорія, педагогічне звання	Педагогічний (науково- педагогічний) стаж (повних років)	Інформація про попередню роботу (період (років), найменування організації, займана посада)	Примітка (з якого часу працює у закладі освіти за основним місцем роботи або сумісництвом)
Когут Ігор Тимофійович	Львівський політехнічний інститут, 1975 р, диплом А-ІІ № 087482, спеціальність - «напівпровідникові прилади», кваліфікація - «інженер електронної техніки»	Доктор технічних наук зі спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка, диплом ДД 008494, Тема дисертації: «Елементи мікросистем на базовому матричному кристалі зі структурою «кремній-на- ізоляторі», 2010 р. професор кафедри радіофізики і електроніки, атестат 12ПР № 007566	32 роки	1 рік, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, професор кафедри радіофізики і електроніки	з 2000 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Р.І. Запужляк